

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40,
Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники.

Председателю диссертационного совета
24.2.415.03, созданного на базе Томского
государственного университета систем
управления и радиоэлектроники, д.ф.-м.н.,
профессору Шандарову С.М.

Уважаемый Станислав Михайлович!

Подтверждаю свое согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации Томашевича Александра Александровича «Процессы дефектообразования в гетероструктуре GaN-светодиодов с множественными квантовыми ямами» по специальности 1.3.5 – «Физическая электроника» на соискание ученой степени кандидата технических наук. Сведения, необходимые для размещения на сайте ТУСУР, прилагаются.

Д.ф.-м.н., Профессор кафедры
физики полупроводников
Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

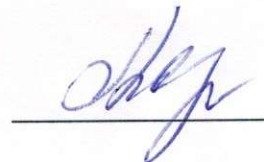
 В.Н. Брудный



Подпись Брудного В.Н. заверяю

Ученый секретарь Национального
исследовательского Томского
государственного университета

М.П.



Л.П. Борило

ЗАТВЕРЖАЮ
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ТГУ
Н.А. САЗОНОВА

Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Томашевича Александра Александровича «Процессы дефектообразования в гетероструктуре GaN-светодиодов с множественными квантовыми ямами» по специальности 1.3.5 – «Физическая электроника» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Фамилия, имя, отчество	Брудный Валентин Натанович
Гражданство	Российская Федерация
Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор физико-математических наук 01.04.10 – «физика полупроводников» / 01.04.07 – «физика конденсированного состояния»
Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор по кафедре физики полупроводников
Основное место работы	
Должность	Директор НОЦ «Нанозлектроника»
Наименование подразделения (кафедра, лаборатория)	НОЦ «Нанозлектроника»
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (НИ ТГУ).
Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, телефон, адрес электронной почты организации	634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; www.tsu.ru; Тел.: +7 (3822) 529 665; E-mail: delo@mail.tsu.ru
Публикации по специальности 1.3.5 – «Физическая электроника»	
1. Способ изготовления Т-образного гальванического затвора в высокочастотном полевом транзисторе / Н.А. Торхов, В.Н. Брудный, П.А. Брудный // Патент на изобретение 2746845 С1, 21.04.2021. Заявка №2020128435 от 27.08.2020.	
2. Features of radiation changes in electrical properties of InAlN/GaN HEMTs / A.G. Afonin, V.N. Brudnyi, P.A. Brudnyi, L.E. Velikovskii // Russian Physics Journal. – 2020. – Vol. 62, № 9. – P. 1656-1662.	
3. Fermi level pinning and hydrostatic pressure effect in electron irradiated GaSb / V. N. Brudnyi, I. V. Kamenskaya, P. A. Brudnyi // Semiconductor science and technology. – 2020. – Vol. 35, № 8. – P. 085021 (1-5).	
4. Твердые растворы In _x Al _{1-x} N: проблемы стабильности состава / В.Н. Брудный, М.Д. Вилисова, Л.Э. Великовский // Физика и техника полупроводников. – 2019. – Т. 53, № 12. – С. 1733-1739.	

- | |
|--|
| 5. Способ изготовления высокочастотного транзистора с дополнительным активным полевым электродом / Н.А. Торхов, В.Н. Брудный // Патент на изобретение RU 2707402 С1, 26.11.2019. Заявка № 2019109007 от 28.03.2019. |
| 6. Особенности радиационных изменений электрических свойств InAlN/GaN НЕМТ / А. Г. Афонин, В. Н. Брудный, П. А. Брудный. // Известия вузов. Физика. – 2019. – Т. 62. № 9 (741). – С. 106-112. |
| 7. Neutron irradiation-induced modification of electrical and structural properties of GaN epilayers grown on Al ₂ O ₃ (0001) substrate / V.N. Brudnyi, A.V. Kosobutsky, P.A. Brudnyi, V.M. Boiko, N.G. Kolin [et al.] // Semiconductor Science and Technology. – 2018. – Vol. 33, № 9. – P. 095011 (1-8). |
| 8. Диффузия магния в светодиодных структурах с квантовыми ямами InGaN/GaN при реальных температурах роста p-GaN 860-980 °С / И. С. Романов, И. А. Прудаев, В. Н. Брудный // Известия высших учебных заведений. – Физика. – 2018. – Т. 61, № 1. – С. 164-166. |

Официальный оппонент



В.Н. Брудный

Подпись Брудного В.Н. заверяю



СЕКРЕТАРЬ ТГУ

Н. А. САЗОНОВА

Ученый секретарь Национального
исследовательского Томского
государственного университета



Л.П. Борило

М.П.